

Письма в ЖЭТФ, том 15, вып 9, стр. 580 – 583

5 мая 1972 г.

**К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ γ -ЛАЗЕРА
НА ОСНОВЕ РАДИОАКТИВНЫХ КРИСТАЛЛОВ**

Р. В. Хохлов

Возможность создания γ -лазера на основе использования мессбауэровского излучения без отдачи энергии ядрам в кристаллах неоднократно обсуждались в литературе [1 – 7]. В результате этого обсуж-

дения выявились серьезные трудности, стоящие на пути реализации γ -лазера, из-за которых, насколько известно автору, серьезных попыток его осуществления до сих пор не предпринималось.

Настоящая статья посвящена развитию работ [1 – 7], в котором показывается принципиальная возможность создания γ -лазера на основе кристаллов, состоящих из долгоживущих ядерных изомеров.

При падении на возбужденное ядро резонансного γ -кванта эффективное сечение σ вынужденного испускания ядром нового γ -кванта, когерентного с падающим, описывается формулой Брейта – Вигнера [1 – 3].

$$\sigma = \frac{\lambda^2}{2\pi} \frac{1 + 2I_2}{1 + 2I_1} f \frac{1}{\Gamma\tau} \frac{1}{1 + a}, \quad (1)$$

где λ – длина волны излучения, I_2 и I_1 – спины верхнего и нижнего состояний ядра, f – вероятность испускания γ -кванта без отдачи энергии ядру, Γ – ширина линии испускания, τ – время жизни возбужденного состояния, a – коэффициент внутренней конверсии.

Коэффициент усиления β -излучения равен

$$\beta = \sigma N, \quad (2)$$

где N – разность числа возбужденных ядер и ядер находящихся на нижнем рабочем уровне.

Оценим факторы, определяющие величину коэффициента усиления.

При обогащении кристалла возбужденными ядрами существенно превышающим 50% значение N равно по порядку 10^{22} см^{-3} . Имея в виду переходы без отдачи энергии, величину λ следует взять порядка $1 \div 3 \cdot 10^{-9} \text{ см}$, а f – порядка единицы. Предполагая также, что переход не сильно конвертирован, можно, в качестве оценки принять

$$\beta = (10^3 + 10^4) \frac{1}{\Gamma\tau}. \quad (3)$$

Для того, чтобы вынужденное испускание γ -квантов имело бы место, нужно, чтобы коэффициент усиления β превосходил бы коэффициент поглощения δ , который равен по порядку 1 см^{-1} . Таким образом, для получения вынужденного γ -излучения необходимо, чтобы ширина линии испускания Γ превосходила бы естественную ширину $1/\tau$ не более, чем на три – четыре порядка величины.

Для приготовления кристалла, удовлетворяющего сформулированным ниже условиям, необходимо, по-видимому, время порядка нескольких дней, что налагает требование на времена жизни возбужденных состояний $\tau \geq 10^6 \text{ сек}$.

В мессбауэровской спектроскопии, в которой используются короткоживущие возбужденные состояния $\tau < 10^{-6} \text{ сек}$, параметр $\Gamma\tau$ равен по порядку единице. Для долгоживущих состояний линия уширяется и перестает зависеть от времени жизни. Экспериментальных работ по изучению уширения спектральных линий долгоживущих состояний почти нет. Исключение составляет работа [8], в которой для 93кэВ перехода ядра Ag^{107} со временем жизни 44 сек было косвенно измерено значение $\Gamma\tau \approx 10^6$.

Следует отметить, что измерения относительно небольших уширенных долгоживущих переходов невозможно проводить обычными методами мессбауэровской спектроскопии. Поэтому необходима разработка новых методов, один из которых предложен в [9]. Он основан на различии в вероятностях излучения из-за гравитационного смещения частоты в вертикальном и горизонтальном направлениях ядер, находящихся в одном и том же кристалле.

Так же, как и в оптике, необходимо различать однородные и неоднородные уширения линий. Различные квазистатические случайные условия, в которых находятся разные участки кристалла (температура, механические напряжения, гравитационный потенциал и т. п.) приводят к неоднородному уширению линии. В экспериментах [8] уширение линии являлось, по-видимому, неоднородным. Такое уширение, по крайней мере принципиально, может быть устранено. Поэтому первое условие, которому должен удовлетворять кристалл для γ -лазера отсутствие (или минимум) дефектов, однородность температуры и т. д. Быстрые флуктуации электронных состояний атомов, колебания атомов в кристаллической решетке и т. п. являются причиной однородного уширения. Теоретические исследования однородных уширений [10 – 14] показывают, что в бездефектном кристалле при низких температурах уширение может быть сведено до значений $\Gamma\tau = 10 \div 10^2$ и даже меньших.

Таким образом, теоретические оценки показывают принципиальную возможность создания γ -лазеров на основе использования долгоживущих изомеров. Для отыскания подходящих для этого ядерных переходов необходимы систематические экспериментальные исследования сверхузких линий γ -излучения методами, отличными от мессбауэровских.

Автор выражает благодарность Р.Н.Кузьмину, И.И.Собельману и В.С.Шпинелю за плодотворное обсуждение вопросов, изложенных в настоящей статье.

Московский
государственный университет
им. М.В.Ломоносова

Поступила в редакцию
6 апреля 1972г.

Литература

- [1] Л.А.Ривлин. Заявка на изобретение №709414 от января 1961 г.; №710508 от 1 апреля 1961 г.
- [2] W.Vali, V.Vali. Proc. IEEE, 51, 182, 1963.
- [3] G.C.Baldwin et al. Proc. IEEE, 51, 849, 1963.
- [4] Б.В.Чириков. ЖЭТФ, 44, 2016, 1963.
- [5] Д.Ф.Зарецкий, В.В.Ломоносов. ЖЭТФ, 48, 368, 1965.
- [6] I.H.Terhune, C.C.Baldwin. Phys. Rev Lett., 14, 589, 1965.
- [7] А.М.Афанасьев, Ю.Каган. Письма в ЖЭТФ, 2, 130, 1965.
- [8] Г.Е.Бизика и др. ЖЭТФ, 45, 1408, 1963.

- [9] C.A.Mead. Phys. Rev., 143, 990, 1966.
 - [10] R.H.Silsbee. Phys. Rev., 128, 1726, 1962.
 - [11] М.А.Кривоглаз. ФТТ, 6, 1707, 1964.
 - [12] Ю.Каган. ЖЭТФ, 47, 366, 1964.
 - [13] А.М.Афанасьев, Ю.Каган. ЖЭТФ, 45, 1660, 1963.
 - [14] Ю.Каган, А.М.Афанасьев. ЖЭТФ, 47, 1108, 1964.
-